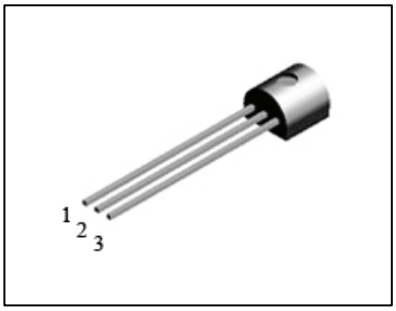
КТ502
кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
p-n-p транзистор

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.

Зарубежный прототип

- Прототип KSA539



Обозначение технических условий

- аАО. 336.182 ТУ/02

Особенности

- Диапазон рабочих температур от - 45 до + 100°С
- Комплиментарная пара КТ503

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	База
№3	Коллектор

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ502 при $T_{окр. среды}$ = 25 °С

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Гр. напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо гр.	В	Iк=-10mA, Iб=0	-25-80	
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб= Uкб max		-1
Статический коэффициент передачи тока	h_{21E}		Uкэ=-5В, Iк=-10 мА	40	240
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк=-10 мА, Iб=-1 мА		-0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ(нас)*	В	Iк=-10 мА, Iб=-1 мА		-1,2
Граничная частота коэф. передачи тока	fгр. *	МГц	Uкб= -5В, Iэ=--3 мА	5	
Емкость коллекторного перехода	Ск *	пФ	Uкб= -5В, f=1МГц		50

* Справочные параметры

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ502

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	-40-90
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэ max	В	-25-80
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	-5
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	-150
Импульсный ток коллектора (tи ≤ 10 мс, Q ≥ 10)	Iки max	мА	-300
Рассеиваемая мощность коллектора	Рк max	мВт	350
Температура перехода	Tj	°С	150

Таблица 3. Классификация КТ502

	КТ502А	КТ502Б	КТ502В	КТ502Г	КТ502Д	КТ502Е
Uкб max, В	-40	-40	-60	-60	-80	-90
Uкэ max, В	-25	-25	-40	-40	-60	-80
Uкэо гр.	-25	-25	-40	-40	-60	-80
h21e	40-120	80-240	40-120	80-240	40-120	40-120